

电子科学与工程学院（微电子学院）硕士研究生中期
考核安排表-宽禁带半导体方向

一、考核时间：2025 年 6 月 18 日（周三） 13 时 40 分

二、考核地点： 华南师范大学南海校园 电子科学与工程学院（微电子学院）行政楼 3 楼 317 会议室

三、考核小组成员

考核小组成员	姓 名	职 称	硕/博导	工 作 单 位	备 注
	陈心满	研究员	博导	华南师范大学	组长
	朱凝	副研究员	硕导	华南师范大学	成员
	张钰	副研究员	硕导	季华实验室	成员
	刘铁忠	副研究员	硕导	华南师范大学	秘书

四、考核学生

序号	学生姓名	导师姓名	专业名称	论文题目	时间安排
1	朱玲慧	王幸福	光电信息工程	直接键合构筑 GaN 微米线/Si 异质结及其压电传感性能研究	13:40-13:55
2	杨帆	郑树文	光电信息工程	氮化镓基垂直 MOSFET 器件的设计与研究	13:55-14:10
3	李欣欣	郑树文	光电信息工程	功率型氮化镓基 HEMT 器件的性能研究	14:10-14:25
4	岳富宁	李述体	集成电路工程	GaN 基微米线激光器的制备与性能研究	14:25-14:40
5	严飏	王幸福	集成电路工程	负压偏置 SiC MOSFET 驱动电路研究与设计	14:40-14:55

6	许世罕	王幸福	集成电路工程	AlGaN 基远紫外发光材料与器件	14:55-15:10
7	吴新宇	李述体	集成电路工程	p-GaN 增强型 hemt 的击穿特性研究	15:10-15:25
8	曲也乐	尹以安	集成电路工程	基于双栅 GaN 射频器件的源漏电极的结构优化	15:25-15:40
9	卢文杰	高芳亮	集成电路工程	低维氮化镓材料的制备及其光电性能研究	15:40-15:55
10	杜家豪	尹以安	集成电路工程	基于新型铁电 AlScN 的可重构 GaN 基 HEMT 器件优化设计	15:55-16:10
11	曾锴	高芳亮	新一代电子信息技术(含量子技术等)	SSiC 功率 MOSFET 多应力耦合下的可靠性研究与失效分析	16:10-16:25
12	易冠凌	高芳亮	新一代电子信息技术(含量子技术等)	基于热-电-机械多应力耦合测试方法的 SiC MOSFET 可靠性与失效机理研究	16:25-16:40
13	王玺	郑树文	新一代电子信息技术(含量子技术等)	SiC 基 MOSFET 隔离驱动电路设计	16:40-16:55
14	赵亚鑫	尹以安	新一代电子信息技术(含量子技术等)	InGaN/GaN 红光量子阱及光泵 VCSEL 研究	16:55-17:10
15	李照坤	尹以安	新一代电子信息技术(含量子技术等)	深紫外半导体发光器的应用研究	17:10-17:25
16	赵维佳	王幸福	集成电路工程	SiC MOSFET 高速驱动电路设计	17:25-17:40
17	庄昌钰	李述体	集成电路工程	碳化硅衬底及外延层缺陷的表征与关联分析	17:40-17:45
18	陈源涛	尹以安	集成电路工程	基于深度学习的 Micro-LED 缺陷检测研究	17:45-18:00

五、考核程序

1. 中期考核组长宣布考核小组成员名单、中期考核研究生姓名、论文题目等，并主持会议。

2. 中期考核答辩以考核小组成员提问、研究生答辩的方式进行。硕士生答辩时间不少于 15 分钟，博士生答辩时间不少于 25 分钟。

3. 中期考核答辩小组针对论文涉及、进展提出具体意见与建议，对参加中期考核的研究生的科研能力、实践能力作出研判，结合研究生《华南师范大学研究生中期考核申请表》中思想政治素质、培养环节等评定情况，通过无记名的方式对参加中期考核的研究生的考核结果给出结论。

4. 考核结果分为通过、跟踪培养和不通过三类。跟踪培养和不通过比例原则上博士生不低于 10%，硕士生不低于 5%。